

3.1.12.1

Um transistor NPN é formado de

- a) uma lâmina delgadíssima de germânio de tipo P colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo N .....
- b) um emissor, uma base mas sem colector .....
- c) uma lâmina delgadíssima de germânio de tipo N colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo P .....
- d) um material emissor de electrões e de protões .....

Nota: ver "Nota" da pergunta nº. 3.1.3.2

3.1.12.2

Um transistor PNP é formado de

- a) uma lâmina delgadíssima de germânio de tipo P colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo N.....
- b) um emissor, uma base mas sem colector .....
- c) uma lâmina delgadíssima de germânio de tipo N colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo P .....
- d) um material emissor de electrões e de protões .....

Nota: ver "Nota" da pergunta nº. 3.1.3.2

3.1.13.1

A polarização dos transistores de base à massa é aplicada do seguinte modo:

- a) base-emissor e base-colector, ambas directas .....
- b) base-emissor, directa e base-colector, inversa .....
- c) base-emissor e base-colector, ambas inversas .....
- d) base-emissor, inversa e base-colector, directa .....